Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0203U000014

Державний реєстраційний номер: 0100U000114

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-01-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження фізичних механізмів нерівноважних процесів на поверхні напівпровідників та в напівпровідникових шаруватих структурах, розробка нових нанотехнологій і приладів на їх основі.

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 044 2654020

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження фізичних механізмів нерівноважних процесів на поверхні напівпровідників та в напівпровідникових шаруватих структурах, розробка нових нанотехнологій і приладів на їх основі.

Назва роботи англійською:

Investigation of physical mechanisms of nonequilibrium processes on the semiconductor surface and in the layered semiconductor structures, development of new nanotechnologies and devices based on them.

Реферат українською:

Проведено дослідження фізичних механізмів електричних, оптичних та фотохімічних явищ в шаруватих та квантово-розмірних напівпровідникових структурах, а також в приладах на основі названих структур. Встановлені особливості фізичних ефектів в просторово обмежених напівпровідникових структурах. Показана перспективність запропонованих наукових підходів для створення приладів нового типу.

Реферат англійською:

The investigations of physical mechanisms for electrical, optical, and photo-chemical phenomena in layered and quantum-size semiconductor structures were performed. The devices based on the structures were also studied. The peculiarities of physical effects in space confined semiconductor structures were established. The availibility of the proposed scientific approaches for new type devices creation was demonstrated.

Індекс УДК: 621.315.55/.58, 621.315.592:383

Коди тематичних рубрик: 45.09.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Литовченко Володимир Григорович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Всього опубліковано 73 роботи в провідних фахових виданнях, Найбільш вагомі з них 1. V.Litovchenko. Physical Rewew B, v.65, 153108 (1-4), 2002.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Свєчніков Сергій Васильович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

